



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

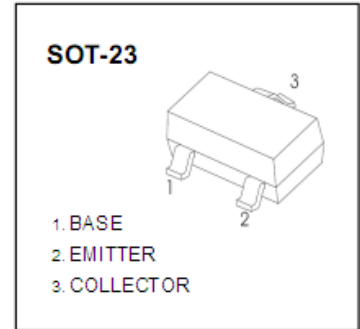
SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

MMBT3906 (PNP)

印章/Marking : 2A

用途/Applications :

用于普通放大与开关，与 MMBT3904 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	-40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	-40	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	-0.2	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C = -10 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C = -1mA, I_B = 0$	-40		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E = -10 \mu A, I_C = 0$	-5		V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB} = -40V, I_E = 0$		-0.1	μA
集电极截止电流	I_{CBX}	$V_{CE} = -30V, V_{BE(off)} = -3V$		-50	nA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$		-0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -10mA$	100	300	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -50mA$	60		
直流电流增益	$h_{FE(3)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -100mA$	30		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -50mA, I_B = -5mA$		-0.4	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -50mA, I_B = -5mA$		-0.95	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -20V, I_C = -10mA, f = 100 MHz$	300		MHz
延迟时间	t_d	$V_{CC} = -3V, V_{BE} = -0.5V,$		35	nS
上升时间	t_r	$I_C = -10mA, I_{B1} = -I_{B2} = -1.0mA$		35	nS
存储时间	t_s	$V_{CC} = -3V, I_C = -10mA,$		225	nS
下降时间	t_f	$I_{B1} = -I_{B2} = -1.0mA$		75	nS



典型特性曲线图/Typical Characteristics

